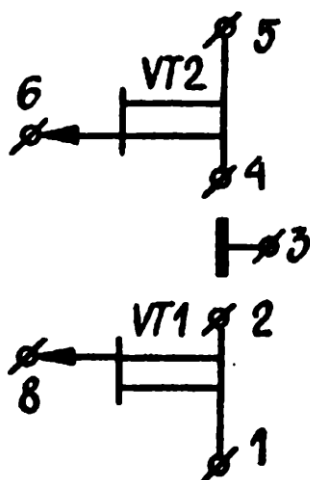


**K504HT1A — K504HT1B,
K504HT2A — K504HT2B,
KP504HT1A — KP504HT1B,
KP504HT2A — KP504HT2B**

Микросхемы представляют собой слаботочную согласованную пару полевых транзисторов, предназначенных для применения во входных каскадах усилителей постоянного тока, в дифференциальных и операционных усилителях и коммутаторах. Корпус типа 301.8-2, масса не более 1,5 г и типа 201.8-1, масса не более 1,8 г.



Электрическая схема K504HT1, KP504HT1, K504HT2, KP504HT2

Назначение выводов: 1 — сток VT1; 2 — исток VT1; 3 — корпус; 4 — исток VT2; 5 — сток VT2; 6 — затвор VT2; 8 — затвор VT1.

Электрические параметры

Напряжение отсечки	≤ 5 В
Разность напряжений затвор — исток K504HT1, KP504HT1	≤ 30 мВ
Начальный ток стока:	
K504HT1A, KP504HT1A, K504HT2A, KP504HT2A	0,1...0,7 мА
K504HT1B, KP504HT1B, K504HT2B, KP504HT2B	0,4...1,5 мА
K504HT1B, KP504HT1B, K504HT2B, KP504HT2B	0,7...2 мА

Ток утечки затвора	≤ 2 нА
Крутизна характеристики:	
К504НТ1А, КР504НТ1А, К504НТ2А, КР504НТ2А	$\geq 0,3$ мА/В
К504НТ1Б, КР504НТ1Б, К504НТ2Б, КР504НТ2Б	$\geq 0,5$ мА/В
К504НТ1В, КР504НТ1В, К504НТ2В, КР504НТ2В	$\geq 0,7$ мА/В
Кoeffициент шума при $R_r = 1$ МОм, $f = 1$ кГц	≤ 4 дБ
Отношение значений крутизны характеристики транзисторов в паре К504НТ2, КР504НТ2	$\geq 0,85$
Температурный дрейф напряжения смещения:	
К504НТ1, КР504НТ1	≤ 50 мкВ/°С
К504НТ2, КР504НТ2	≤ 250 мкВ/°С

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение затвор — сток	10 В
Прямое напряжение затвор — исток	$\geq -0,2$ В
Температура окружающей среды	$-45 \dots +85$ °С